

Miniaturisierung der Stromversorgung: AIXTRON liefert MOCVD-Schlüsseltechnologie an NexGen Power Systems

Unternehmen setzt auf vertikale Transistoren für kleine, effiziente GaN¹-on-GaN-Leistungswandler für verschiedene Anwendungen

Herzogenrath, 19. Juli 2018 – AIXTRON SE (FSE: AIXA), ein weltweit führender Hersteller von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, wird NexGen Power Systems Inc. hochwertige MOCVD-Technologie für die weitere Entwicklung von GaN-basierten elektronischen Bauelementen liefern. Diese sollen den Bau kompakterer, leichter und kostengünstiger Leistungswandler ermöglichen. Zu diesem Zweck hat NexGen die Planetenanlage AIX G5 HT von AIXTRON bestellt: Die Auslieferung ist für Q3/2018 geplant.

In Bezug auf Ausbeute und Betriebskosten stellt die AIX G5 HT den aktuellen Standard für alle fortgeschrittenen GaN-Anwendungen dar. Als einzige MOCVD-Anlage auf dem Markt verfügt die AIX G5 HT über ein integriertes Wafer Level-Kontrollsystem. Damit ist sie die effizienteste Anlage für die Epitaxie von GaN-on-GaN, GaN-on-Si² und GaN-on-SiC³ für Leistungselektronik- und RF-Anwendungen. Die voll automatisierte Anlage bietet In-situ-Reinigung für beste Prozesssicherheit und Fehlerkontrolle und ist zudem mit dem neuesten Laytec InSide P400 UV-Pyrometer zur berührungslosen Temperaturmessung ausgestattet. In Verbindung mit AIXTRONs individuellem On-Wafer-Temperaturkontrollsystem Auto Feed-Forward (AFF) ermöglicht dies eine Anpassung aller Epitaxiewafer - sowohl innerhalb eines Produktionsdurchlaufs als auch bei aufeinanderfolgenden Produktionsdurchläufen („Run-to-Run“).

Dinesh Ramanathan, CEO von NexGen Power Systems, sagt: "Unsere disruptive True GaN™ VJFET⁴-Technologie ist in der Lage, die Silizium-, Siliziumkarbid- oder GaN-on-Silicon-Technologie durch höhere Durchbruchspannung, geringeren On-Widerstand und höhere Schaltfrequenz in ihrer Leistung zu übertreffen. Die True GaN™ Leistungsbaulemente von NexGen ermöglichen das Design von kompakten Leistungswandlern und erhöhen gleichzeitig deren Effizienz bei Anwendungen in der Stromversorgung von Rechenzentren, in Motorantrieben, Solarwechselrichtern und der Antriebstechnik für Elektrofahrzeuge. AIXTRONs Planetentechnologie in Kombination mit seinem Batch-Reaktor-Konzept wird uns sowohl die notwendige Qualitätskontrolle als auch die Kosteneffizienz bieten, um eine schnelle Einführung unserer bahnbrechenden Leistungsbaulemente zu gewährleisten".

"Wir freuen uns darauf, die Anstrengungen von NexGen zu unterstützen, bestehende Leistungswandler zu revolutionieren. In den letzten Jahren haben sich unsere Planetenanlagen vom Typ AIX G5 HT einen guten Ruf als präzise, zuverlässige und kosteneffiziente Produktionsanlagen in der Halbleiterindustrie erworben und ermöglichen eine schnellere

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

Corporate Communications

AIXTRON SE, Dornkaulstr. 2, 52134 Herzogenrath, Germany

PHONE +49 (2407) 9030-444 FAX +49 (2407) 9030-445

E-MAIL info@aixtron.com WEB www.aixtron.com

Einführung von GaN-Bauelementen in den von Silizium bestimmten Markt der Leistungsbaulemente.", sagt Dr. Felix Grawert, Vorstand der AIXTRON SE.

¹GaN = Galliumnitrid, ²Si = Silizium, ³SiC = Siliziumkarbid, ⁴VJFET = Vertical Junction Field Effect Transistor

Über AIXTRON

Die AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen.

Unsere eingetragenen Warenzeichen: AIXACT[®], AIXTRON[®], APEVA[®], Atomic Level SolutionS[®], Close Coupled Showerhead[®], CRIUS[®], EXP[®], EPISON[®], Gas Foil Rotation[®], Optacap[™], OVPD[®], Planetary Reactor[®], PVPD[®], STExS[®], TriJet[®]

Weitere Informationen über AIXTRON (FWB: AIXA, ISIN DE000A0WMPJ6) sind im Internet unter www.aixtron.com verfügbar.

Über NexGen

NexGen Power Systems wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in DeWitt, New York, USA. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung und Herstellung von Technologielösungen unter Verwendung von diskreten GaN-on-GaN-Halbleiterbauelementen, Modulen und Systemen, die die Effizienz und Zuverlässigkeit von Leistungswandlern erhöhen und gleichzeitig deren Kosten, Größe und Gewicht erheblich reduzieren. Leistungswandler spielen eine Schlüsselrolle in fast allen elektronischen Geräten, von Haushaltsgeräten bis hin zu Rechenzentren, Laptops und Elektroautos.

Weitere Informationen unter: www.nexgenpowersystems.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument kann zukunftsgerichtete Aussagen über das Geschäft, die Finanz- und Ertragslage und Gewinnprognosen von AIXTRON enthalten. Begriffe wie "können", "werden", "erwarten", "rechnen mit", "erwägen", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "fortdauern" und "schätzen", Abwandlungen solcher Begriffe oder ähnliche Ausdrücke kennzeichnen diese zukunftsgerichteten Aussagen. Solche zukunftsgerichtete Aussagen geben die gegenwärtigen Beurteilungen, Erwartungen und Annahmen des AIXTRON Managements, von denen zahlreiche außerhalb des AIXTRON Einflussbereiches liegen, wieder und gelten vorbehaltlich bestehender Risiken und Unsicherheiten. Sie sollten kein unangemessenes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen setzen. Sollten sich Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder sollten zugrunde liegende Erwartungen zukünftig nicht eintreten beziehungsweise es sich herausstellen, dass Annahmen nicht korrekt waren, so können die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von AIXTRON wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden sind.. Dies kann durch Faktoren verursacht werden, wie zum Beispiel die tatsächlich von AIXTRON erhaltenen Kundenaufträge, den Umfang der Marktnachfrage nach Depositionstechnologie, den Zeitpunkt der endgültigen Abnahme von Erzeugnissen durch die Kunden, das Finanzmarktklima und die Finanzierungsmöglichkeiten von AIXTRON, die allgemeinen Marktbedingungen für Depositionsanlagen, und das makroökonomische Umfeld, Stornierungen, Änderungen oder Verzögerungen bei Produktlieferungen, Beschränkungen der Produktionskapazität, lange Verkaufs- und Qualifizierungszyklen, Schwierigkeiten im Produktionsprozess, die allgemeine Entwicklung der Halbleiterindustrie, eine Verschärfung des Wettbewerbs, Wechselkursschwankungen, die Verfügbarkeit öffentlicher Mittel, Zinsschwankungen bzw. Änderung verfügbarer Zinskonditionen, Verzögerungen bei der Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte, eine Verschlechterung der allgemeinen Wirtschaftslage sowie durch alle anderen Faktoren, die AIXTRON in öffentlichen Berichten und Meldungen, insbesondere im Abschnitt Risiken des Jahresberichts, beschrieben hat. In dieser Mitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstands basierend auf den zum Zeitpunkt dieser Mitteilung verfügbaren Informationen. AIXTRON übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überprüfung zukunftsgerichteter Aussagen wegen neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen, soweit keine ausdrückliche rechtliche Verpflichtung besteht.

Dieses Dokument liegt ebenfalls in englischer Übersetzung vor, bei Abweichungen geht die deutsche maßgebliche Fassung des Dokuments der englischen Übersetzung vor.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

Corporate Communications

AIXTRON SE, Dornkaulstr. 2, 52134 Herzogenrath, Germany

PHONE +49 (2407) 9030-444 FAX +49 (2407) 9030-445

E-MAIL info@aixtron.com WEB www.aixtron.com